

SSD Samsung MZ-V8P1T0BW

Tipo: interno

Capacidade: 1000 GB

Fator de forma: M.2

Interface M.2: PCI-E 4.0 4x

Controlador: Samsung Elpis

Memria de buffer: 1000 MB / DDR4 /

Tipo de memria: 3D TLC NAND

NVMe: / 1.3c /

Velocidade de gravao externa: 5000 MB/s

Velocidade de leitura externa: 7000 MB/s

Resistncia ao choque em operao: 1500 G

MTBF: 1,5 milho de horas

Gravar IOPS: 1000k

Ler IOPS: 1000k

TBW: 600 TB

DWPD: 0,3 vezes/dia

Garantia do fabricante: 5 anos

TRIM

Dimenses: 22x80 mm

Peso: 7g